フェムト秒レーザーによる YIG 光磁気造形を利用した磁気光学回路 Magneto-optical integrated circuits by femtosecond laser modeling in YIG

^o雨宮 智宏^{1,4}, 顧 之琛²,石川 篤^{4,5}, 庄司 雄哉², P. N. Hai³, 田中 雅明⁶, 水本 哲弥², 田中 拓男^{4,7}, 荒井 滋久^{1,2} ^OT. Amemiya^{1,4}, Z. Gu², A. Ishikawa^{4,5}, Y. Shoji², P. N. Hai³, M. Tanaka⁶, T. Mizumoto², T. Tanaka^{4,7}, and S. Arai^{1,2} 東京工業大学 量子ナノエレクトロニクス研究センター¹, 電気電子工学専攻², 電子物理工学専攻³ 理化学研究所⁴, 岡山大学 産業創成工学専攻⁵, 東京大学 電気系工学専攻⁶, 北海道大学 電子科学研究所⁷ E-mail: <u>amemiya.t.ab@m.titech.ac.jp</u>

1. はじめに

フェムト秒レーザーによる非線形吸収に基づく光 加工技術を用いて、ガラスなどの透明材料中の屈折 率を数百 nm オーダーで局所的に変化させることが可 能となる[1, 2]。我々は、この手法を透明フェリ磁性 材料であるセリウム添加イットリウム鉄ガーネット

(Ce-substituted Yttrium Iron Garnet, 以降 Ce:YIG) に対 して応用し、材料内部の光学(屈折率)および磁気 特性(保磁力)の両方を任意の3次元ナノ領域にお いて変化させることに成功した[3]。

本報告では、この技術を用いて Ce:YIG 内に磁気光 学回路(Magneto-optical integrated circuits、以降 MOIC) を実現する方法を提案する。提案する磁気光学回路 では、任意の場所に、数 µmの間隔で"非相反導波路" および"相反導波路"を集積でき、Ce:YIG 基板内に 光アイソレータ・サーキュレータなどを一括集積し た機能回路を作り上げることが可能となる。

2. 磁気光学回路の提案および光学特性解析

Fig. 1(a)に提案する MOIC の概要を示す。MOIC に おける導波路は、Ce:YIG 表面にフェムト秒レーザー 照射を行うことで実現できる(レーザー照射された 領域は屈折率が増加するため、この部分をコア層と して利用する)。Fig. 1(b)に導波路断面およびモード 分布の計算例を示す。パラメータとなるのは照射領 域幅wと浸透長 hの 2つであり、wについては照射師 の挿引回数を、hについては照射パワー(または照射 位置)を変えることで制御可能である。Fig. 2に浸透 長 hのレーザー照射パワー依存性を示す。膜厚 4 μ m の Ce:YIG ウェハ表面にレーザー照射を行ったサンプ ルを定量位相差顕微鏡で観測した結果、レーザー照 射パワー48 mW で hが 1.35 μ m となることが観測され た(本測定では、あらかじめ得られている屈折率変 化量のデータ[3]から、浸透長 hの逆算を行った)。

レーザー照射された Ce:YIG は、屈折率変化だけで はなく、磁化困難という性質も付加される[3]。その ため、浸透長 h が下地基板(SGGG)まで届いている かどうかで、導波路の非相反性の有無を選択可能と なる(例えば Fig. 1(c)において、導波路 A は磁気的に 非対称となるため非相反性を示す。一方、導波路 B は非相反性を有さない)。本提案に基づいた導波路 の解析結果を Fig. 3 に示す。解析では、Ce:YIG の層 厚を 3 μ m とし、照射前後の Ce:YIG の屈折率を各々 2.2、2.217、および SGGG の屈折率を 1.96 とした。浸 透長 h は前述の結果から 1.35 μ m に固定し、照射領域 幅 w をパラメータとした。wが 4 μ m のとき、シング ルモード伝送が実現され、非相反効果の元となる下 部 YIG 層(Fig. 1(b)の B1 領域)における閉じ込め係 数は 41.5%まで高められることが分かった。







Fig. 3. モード特性(左) および下部 YIG 層(Fig. 1 の B1) に おける閉じ込め係数(右)の導波路幅依存性の解析

Acknowledgment

本研究は、JSPS 科研費 (#24246061, #25709026, #25420321)の援助により行われた。

References

- [1] K. M. Davis et al., Optics Lett. 21, 212 (1996).
- [2] A.Y. Vorobyev et al., Laser & Photon. Rev. 7, 385 (2013).
- [3] T. Amemiya et al., Optics Lett. 39, 212 (2014).